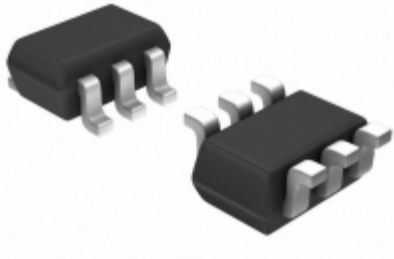

	<h2 style="color: red;">SI1917EDH-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1917EDH-T1-E3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 12V 1A SC70-6
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1917EDH-T1-E3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 23077 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1917EDH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 1A SC70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	23077 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 12V 1A 570mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	570mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	370 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 100µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI1917
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1917EDH-T1-E3TR

SI1917EDH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1917EDH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1917EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1917EDH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1917EDH</b> Vishay Precision Group SI1917EDH VISHAY</p>	 <p><b>SI1922EDH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SOT-363</p>	 <p><b>SI1917EDH-T1-GE3</b> VISHAY SI1917EDH-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI1913EDH-T1-GE3</b> V SI1913EDH-T1-GE3 V</p>
 <p><b>SI19190CTG64</b> SILICON SILICON QFP64</p>	 <p><b>SI19190CT64</b> SILICON SI19190CT64 SILICON</p>	 <p><b>SI1922EDH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SOT-363</p>	 <p><b>SI1917EDH-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 1A SC70-6</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ SI1904EDH-T1	↔ SI1904EDH-T1-GE3	⇒ SI1905BDH-T1-E3	D SI1905BDH-T1-E3	⇒ SI1905BDH-T1-GE3
⊖ SI1905BDH-T1-E3	⊕ SI1905DL	D SI1905DL-T1	⇒ SI1905DL-T1-E3	⇒ SI1905DL-T1-E3
⊕ SI1905DL-T1-GE3	⊖ SI1906DL-T1	⊕ SI1912EDH	↔ SI1912EDH-T1	⇒ SI1912EDH-T1-E3
D SI1912EDH-T1-E3	⊕ SI1912EDH-T1-GE3	⊖ SI1913DH-T1-E3	⊕ SI1913DH-T1-E3	⇒ SI1913DH-T1-GE3
⇒ SI1913EDH-T1	↔ SI1913EDH-T1-E3	⊕ SI1913EDH-T1-E3	⊖ SI1913EDH-T1-GE3	⇒ SI1917EDH-T1
↔ SI1917EDH-T1-E3	⇒ SI1917EDH-T1-GE3	D SI1922EDH-T1-GE3	⊕ SI1922EDH-T1-GE3	⊖ SI1926DL-T1-E3
⊕ SI1926DL-T1-E3	D SI1926DL-T1-GE3	⇒ SI1926DL-T1-GE3	↔ SI1958DH-T1-E3	⇒ SI1958DH-T1-E3
⊖ SI1965DH-E3	⊕ SI1965DH-T1-E3	↔ SI1965DH-T1-E3	⇒ SI1965DH-T1-GE3	⇒ SI1965DH-T1-GE3
⊕ SI1967DH-T1-E3	⊖ SI1967DH-T1-E3	⊕ SI1967DH-T1-GE3	D SI1967DH-T1-GE3	⇒ SI1969DH-E3
↔ SI1970DH-T1-GE3	⊕ SI1970DH-T1-GE3	⊖ SI1972DH-T1	⊕ SI1972DH-T1-E3	⇒ SI1972DH-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited